

2015 年

- 2015-J1(C) 前田 康貴、大見 俊一郎、後藤 哲也、大見 忠弘、「窒素添加 LaB₆ 薄膜上に形成したペンタセン薄膜の堆積レート依存性」、第 62 回応用物理学学会春季学術講演会 講演予稿集、(公益社団法人応用物理学学会)、11-001、(11a-D2-1)、2015 年 3 月。
- 2015-J2(C) 黒田理人、後藤哲也、赤川直也、木本大幾、寺本章伸、須川 成利、「ゲート絶縁膜/Si 界面の原子オーダー平坦化によるランダムテレグラフノイズ低減効果」、映像情報メディア学会技術報告・情報センシング研究会, Vol.39、No.17、pp.35-38. 2015 年 5 月。
- 2015-J3(W) 諏訪智之、寺本章伸、後藤哲也、平山昌樹、須川成利、大見忠弘、「Xe/H₂ プラズマを用いたシリコン基板表面の低温平坦化技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.115、No.280、シリコン材料・デバイス(一般社団法人電子情報通信学会)、SDM2015-73 (2015-10)、pp.13-16、2015 年 10 月。
- 2015-J4(W) 古川貴一、寺本章伸、黒田理人、諏訪智之、橋本圭市、小尻尚志、須川成利、「トンネル電流・拡散電流併用 MOSFET のデバイスシミュレーション検討」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.115、No.280、シリコン材料・デバイス(一般社団法人電子情報通信学会)、SDM2015-77 (2015-10)、pp.35-40、2015 年 10 月。
- 2015-J5(W) 今泉文伸、後藤哲也、寺本章伸、須川成利、「酸素ラジカル処理を用いた強誘電体 BiFeO₃ 薄膜の形成技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.115、No.280、シリコン材料・デバイス(一般社団法人電子情報通信学会)、SDM2015-78 (2015-10)、pp.41-44、2015 年 10 月。
- 2015-J6(W) 石井秀和、高橋健太郎、後藤哲也、須川成利、大見忠弘、「窒素添加 LaB₆ ターゲットによる低仕事関数 LaB₆ スパッタ薄膜の形成」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.115、No.280、シリコン材料・デバイス(一般社団法人電子情報通信学会)、SDM2015-81 (2015-10)、pp.53-56、2015 年 10 月。
- 2015-J7(W) 杉田久哉、幸田安真、諏訪智之、黒田理人、後藤哲也、石井秀和、山下哲、寺本章伸、須川成利、大見忠弘、「高精度ガス制御器を用いた Al₂O₃ の ALD 成膜におけるプロセス温度の検討」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.115、No.280、シリコン材料・デバイス(一般社団法人電子情報通信学会)、SDM2015-83 (2015-10)、pp.63-68、2015 年 10 月。
- 2015-J8(W) 宮本 直人、森本 達郎、磯村 明宏、小原 幸子、ボノー パトリック、三浦 隆治、鈴木 愛、畠山 望、宮本 明、八重樫 祐介、「計測融合計算化学を活用したスノースポーツ用品の最適化—スキーワックスの摩擦係数測定—」、第 27 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.31-34、2015 年 11 月。
- 2015-J9(W) 今泉 文伸、後藤 哲也、寺本 章伸、須川 成利、「BiFeO₃ 薄膜への酸素ラジカル処理と低温結晶化技術」、第 27 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.35-38、2015 年 11 月。
- 2015-J9(W) 大見忠弘、「新しい半導体生産方式:「生産現場に学問を」を具現化する時代の到来、新しいシリコン産業の創出」、第 27 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.39-53、2015 年 11 月。
- 2015-J11(W) 寺本章伸、酒井健、田寺克己、高橋常二郎、高橋正好、今泉文伸、白井泰雪、「マイクロ・ナノバブルの半導体洗浄への応用—イオン注入フォトレジストの除去—」、第 4 回学術総会マイクロ・ナノバブルの発生・評価技術の確立と応用(一般社団法人日本マイクロ・ナノバブル学会)、pp.14、2015 年 12 月。
- 2015-J12(W) 小尻尚志、諏訪智之、橋本圭市、寺本章伸、黒田理人、須川成利、「高い選択比をもつ SiN_x エッチングガスを用いた FinFET 構造の作製」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.115、No.362、電子ディスプレイ(一般社団法人電子情報通信学会)、EID2015-9、SDM2015-92 (2015-12)、pp.1-4、2015 年 12 月。